

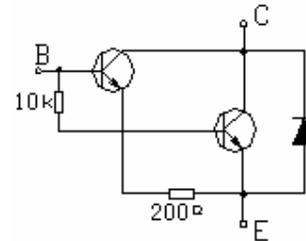
## TIP112

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 " )

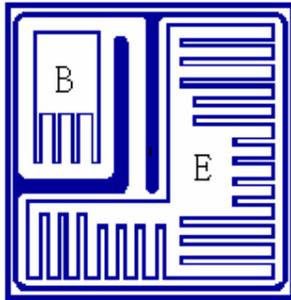
### ■用途

- \* 电源调整管
- \* 音频功率放大器
- \* 其他电子电路

### ■内部结构:



### ■芯片示意图



### ■芯片结构

芯片尺寸	1800 μ m × 1800 μ m
焊区尺寸	基区 380 μ m × 470 μ m 发射区 380 μ m × 530 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.3 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

### ■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=0.1mA, I_E=0$	260	210		V
集电极--发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	150	100		V
集电极--发射极维持电压	$V_{CEO(sus)}^*$	$I_C=30mA, I_B=0$		100		V
发射极--基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_B=1mA, I_C=0$		8		V
集电极--基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=100V, I_E=0$			1	μ A
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=100V, I_B=0$			1	μ A
发射极--基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=10V, I_C=0$	1		1.25	mA
直流电流增益	$h_{FE1}$	$V_{CE}=3V, I_C=0.5A$		1000	15000	
直流电流增益	$h_{FE2}$	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	4000	2000	15000	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CES}$	$I_C=3A, I_B=12mA$	1.3		1.8	V

\*  $V_{CEO(sus)}$ : 脉宽 ≤ 300 μ s, 占空比 ≤ 2% (TO—220)